



life.augmented

新聞稿



800V MDmesh™ K6 series STPOWER MOSFET
raises power density and efficiency



意法半導體新MDmesh™ K6 800V STPOWER MOSFET 提升效能，大幅降低開關功率損耗

【台北訊，2021年10月28日】— 服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）新推出之新超接面STPOWER MDmesh K6系列強化了幾個關鍵參數，以降低系統的功率損失。特別適合返馳式拓撲為基礎的照明應用，例如LED驅動器、HID燈，或是適用於電源適配器和平板顯示器的電源。

意法半導體800V STPOWER MDmesh K6系列為這種超接面技術樹立了兼具高性能和易用性的標準。MDmesh K6的導通阻抗x晶片面積參數優於市面上現有800V產品，能夠實現結合高功率密度並領先市場效能的緊密全新設計。

此外，K6系列的閘極閾值電壓相較上一代MDmesh K5更低，可使用更低的驅動電壓，進而降低功耗並提升效能，主要用於待機零功耗的應用。總閘極電荷（ Q_g ）極低，以實現高開關速度和低損耗。

晶片上結合一個ESD保護二極體，將MOSFET的整體耐用性提升到人體放電模型（Human Body Model，HBM）2級。

義大利固態照明創新企業TCI的技術長暨研發經理Luca Colombo表示，「我們已經測試評估了新的超接面高壓MDmesh K6系列的樣品，並注意到其出色的導通阻抗 x 晶片面積和總閘極電荷（ Q_g ）效能。」

採用TO-220通孔封裝的STP80N240K6（ $R_{DS(on)max} = 0.22\Omega$ ， $Q_{gtyp} = 25.9nC$ ）是首批量產的MDmesh K6

MOSFET，[ST eStore](#)網上商店現已提供免費樣品。DPAK和TO-220FP版本將於2022年1月前量產。

意法半導體將於2022年前推出MDmesh K6的完整產品組合，將產品導通電阻的範圍從0.22Ω擴大至4.5Ω，並增加一系列封裝選擇，包括SMD和通孔包裝。

更多資訊，請造訪：www.st.com/stpower-800v-mdmesh-k6。

關於意法半導體

意法半導體 (STMicroelectronics ; ST) 擁有46,000名半導體技術、產品和方案的創新和創造者，掌握半導體供應鏈和最先進的製造設備。作為一家獨立的半導體設備製造商，意法半導體與逾十萬客戶、上千合作夥伴一起研發產品和解決方案，共同打造生態系統，一同攜手應對各種挑戰和機會，滿足世界對於永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧、電力和能源管理更高效、物聯網和5G技術應用更廣泛。詳情請瀏覽意法半導體公司網站：www.st.com。